

Procedeu de obținere a nanofirelor semiconductoare cu bandă interzisă largă pe un suport semiconductor cu bandă interzisă îngustă, care constă în fabricarea nanofirelor de GaAs sau InP prin metoda anodizării suportului semiconductor de n-GaAs sau n-InP în electrolit, după care suportul cu nanofirele fabricate se supune tratamentului termic la temperatura de 900°C, timp de 60 min, în atmosferă inertă de flux de Ar cu un conținut de oxigen de 3%, până la obținerea pe suportul de GaAs sau InP a nanofirelor de Ga₂O₃ sau In₂O₃, corespunzător.